

s 2019 0002

Изобретение относится к области производства термоэлектрических материалов с направленной анизотропией, а именно к способу рекристаллизации микропровода висмута в стеклянной изоляции.

Способ рекристаллизации микропровода висмута в стеклянной изоляции состоит в том, что движущийся микропровод висмута нагревается до температуры плавления, образуя расплавленную зону, которая движется вдоль движения микропровода через конденсатор, который генерирует сильное электрическое поле, где рекристаллизуется в водяном кристаллизаторе, с направлением кристаллографической оси C_3 микропровода по направлению электрического поля. Конденсатор выполнен из двух медных пластин, расположенных на расстоянии 1 см одна относительно другой.

П. формулы: 1

Фиг.: 5